

論文の内容の要旨

Structural study of the cleavage and the sequence-specific recognition of
the double-stranded DNA substrate by *VMA1*-derived endonuclease

論文題目 (酵母*VMA1*遺伝子由来エンドヌクレアーゼによる基質二本鎖DNAの特異的認識と切断の機構に関する構造生物学的研究)

氏名 宮元 俊輔

【序】

酵母の*VMA1* (Vacuolar membrane ATPase subunit 1) 遺伝子は、その中間に*VDE* (*VMA1*-derived endonuclease) 遺伝子が内包されている。*VMA1*は1本のポリペプチド鎖の*VMA1*産物として翻訳され、この*VMA1*はプロテインスプライシング反応によってエンドヌクレアーゼ*VDE*と*VMA1*サブユニットを生ずる。*VDE*は自己の遺伝子を欠失した*VMA1ΔVDE*遺伝子を31塩基長にわたって認識し、互いに4塩基長離れた2か所で切断する。切断された箇所に*VDE*遺伝子が挿入されることにより、*VDE*は自己の遺伝子を酵母のゲノム中に伝播する。このような自己の遺伝子の伝播機構は、遺伝子ホーミングと呼ばれている。本研究では*VDE*の認識配列を含んだ二本鎖DNAと、*VDE*との複合体の三次元構造をX線構造解析の手法を用いて解析し、*VDE*による遺伝子の配列の特異的な認識と二本鎖DNAの切断の機構を考察した。

【方法・結果】

大腸菌BL21(DE3)pLysS 発現系より調製した*VDE*と、図1に示す34塩基対からなる基質DNAとの複合体を形成させた。複合体の動的光散乱を測定したこところ、推定分子量が6万4千



図1. *VDE*の基質DNA配列
濃い字で示した部分は結晶化した複合体の二本鎖DNAの配列を表す。

の単分散を示した。複合体は 1 分子の VDE (分子量 5 万 1 千) に対して 1 分子の基質 DNA (分子量 2 万 1 千) が安定な複合体を形成しているものと考えられる。

34 塩基対からなる基質 DNA、およびその 2 ヶ所の切断部位の一方のみをあらかじめ切ってある 2 種類の二本鎖 DNA が、VDE により切断されるか否かを、ゲルろ過クロマトグラフィーにより観察した。その結果、コード鎖の +3 位と +2 位の間をあらかじめ切っておいた二本鎖 DNA についてのみ、二本鎖の切断が生じなかった。したがって、VDE による二本鎖の切断において、相補鎖の切断にはコード鎖における切断の有無が強く関与するのに対して、コード鎖の切断には相補鎖の切断の有無は関与しないと考えられる。

VDE により特異的に認識される塩基配列をもち、鎖長の異なる 49 種類の二本鎖 DNA を調製し、切断活性に必須な Mg^{2+} の非存在下で各々と VDE との複合体を形成させた。図 1 において太字で示す、19 塩基長からなる DNA 鎖 (S 鎖) と 31 塩基長からなる DNA 鎖 (A 鎖) が形成する 2 本鎖の DNA と VDE との複合体より、ポリエチレングリコール 3350 を結晶化剤とする蒸気平衡拡散法を用いて、結晶を析出させた。その結晶学的パラメーターを(表 1) に示す。

表 1. 結晶学的パラメータ

大きさ	$0.15 \times 0.40 \times 0.50 \text{ mm}^3$
空間群	$P 2_1$
格子定数	$a = 98.7 \text{ \AA}, b = 65.5 \text{ \AA}, c = 120.9 \text{ \AA}, \beta = 103.2^\circ$
$V_M (f_{\text{solv}})$	$2.86 \text{ \AA}^3/\text{Da} (0.57)$
非対称単位中の分子数	2

表 2. 結晶学的構造精密化

分解能	$10.0 - 2.5 \text{ \AA}$
反射数 (独立な反射数)	121,575 (50,830)
観測可能な反射数に対する割合	0.97
タンパク質原子数 / DNA 原子数	$3,350 \times 2 (782 \times 2)$
水分子数	410
$R (R_{\text{free}})$	0.202 (0.256)

100 K に保持した結晶に波長 0.75 \AA のシンクロトロン放射光 X 線を照射して、2.5 \AA 分解能までの回折データを収集した。DNA と複合体を形成していない (非複合体) VDE の構造を探索分子とする分子置換法により位相を決定し、プログラム CNS を用いて結晶学的構造精密化を行った (表 2)。非対称単位中の 2 分子における主鎖 Ca 原子の根二乗平均差異は 0.6 \AA である。差異は結晶中で分子同士が接触する領域に多く生じている。

精密化された複合体の構造において、二本鎖 DNA は A 鎖の 3'末端より 19 塩基長にわたって塩基対を形成しており、塩基対を形成している部分はほぼ直線状の B 型 DNA の構造をとっている (図 2)。19 塩基長の DNA の領域は、その表面積の 53% にあたる $3,700 \text{ \AA}^2$ の接触面積にわたって、43 ヶ所において、VDE と van der Waals 接触している。また、VDE と二本鎖 DNA の空隙には 27 個の水分子が両者を水素結合で橋渡ししている。VDE のプロテインスプライシング反応の活性残基である N 末端、C 末端の両残基は、二本鎖 DNA とは接触していない。

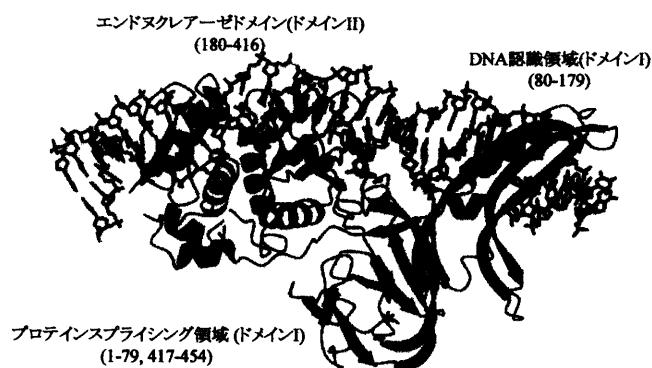


図2. 複合体の全体構造

*位はプロテインスプライシング部位、括弧の中の数字は残基番号、薄い線で示した部分は仮想的なモデル構造を表す。

複合体中の VDE の構造と非複合体 VDE の構造を、ドメイン II を中心に重ね合わせると、複合体中においては非複合体に比べ、ドメイン I の DNA 認識領域を構成する部分がドメイン II より遠ざかる方向に約 5 Å 移動している。また、複合体のドメイン I における 52 番から 72 番にかけての残基が形成するループ構造は、非複合体の同じ部分の構造に比べて大きく変化することによって、DNA との相互作用を形成している。これら非結合体に比べて構造の変化が大きい領域では、VDE のアミノ酸残基は直接 DNA との間に水素結合を形成している。

+3 位とグアノシンの塩基部分と+4 位のリン酸基は、ドメイン II のアミノ酸残基との間に水素結合を形成している。+5 位から+9 位のリン酸基骨格部分は、ドメイン I とドメイン II のプロテインスプライシング領域との間に 7 本の水素結合を形成している。+15 位から+21 位の major groove はドメイン II の DNA 認識領域の 3 つの β シートとの間に、7 本の水素結合を形成している。

【考察】

複合体の構造中、VDE のドメインにおいて DNA と相互作用を形成している領域のうち、

DNA 認識領域は DNA の塩基部分と 4 本の水素結合を形成しており、基質の塩基配列の認識を行うと考えられる。とくに、+16 位、+18 位、+19 位の 3 つの塩基対の、いずれかひとつでも別の塩基対に変異させた二本鎖 DNA は VDE によって切断されなくなることが知られている。S 鎖の +18 位のグアニン塩基の O6 の原子は Arg 94 の N ϵ 1 と、N7 はやはり N ϵ 1 と水分子を介しても水素結合を形成している。A 鎖の +19 位のチミン塩基の O4 は Arg 94 の N ϵ 2 と、+18 位のシトシン塩基の N4 は Glu 103 の O ϵ 1 と水を介して水素結合を形成している（図 3）。Glu 103 O ϵ 2 は Arg 94 N ϵ と水素結合している。この水素結合はネイティブ体には見られず、塩基との水素結合によって生じる。+16 位の塩基対の認識には Arg 90, His 170 が寄与している。

ドメイン I におけるプロテインスプライシング領域において、VDE は DNA の塩基部分と直接の水素結合を形成していない。したがって、VDE の、+5 位から+14 位にかけての塩基配列に対する認識の特異性は低いであろう。

S 鎖の+3 位と+4 位の塩基配列は、両方のグアノシンの O6 原子と Lys 340 N ζ との水素結合により認識されている。この水素結合は、コード鎖の切断部位にあたる+3 位のグアノシンのリン酸基を VDE の活性部位に配置している。

複合体の構造より、VDE は主として、特異的な認識配列において S 鎖の 3'末端側に位置する major groove と、コード鎖が切断される部分の塩基配列を特異的に認識している。

VDE の認識配列は 31 塩基長にも及ぶが、塩基の構造が特異的に認識される部分は限られている。VDE は認識配列中に配列特異性の低い部分を有するために、基質配列に微小な

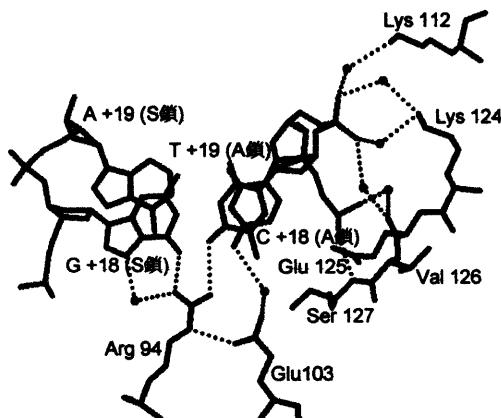


図3. +18, +19位の塩基対の認識 (DNA認識領域)

濃い線はタンパク質、薄い線はDNA、丸は水分子、点線は水素結合を表す。

変異の入った場合でも切断が妨げられずに遺伝子ホーミングを生じることができると考えられる。

二本鎖DNAの切断に二価イオンを必要とするEcoRIやEcoRVでは、アスパラギン酸のOε原子に配位した二価イオンが、求核攻撃をうけるリン酸基の負電荷を安定化すると考えられている。VDEにおいて同様の切断機構を仮定すると、コード鎖の+3位のグアノシンのリン原子と相補鎖の-3位のシチジンのリン原子が求核攻撃を受ける。

VDEによる二本鎖DNAの切断機構を考察するために、+2位から-10位までの二本鎖DNAを、直線状のB型DNAの構造をとると仮定して、複合体の構造に継ぎ足したモデルを作った。このモデルにおいてコード鎖の+3位のグアノシンのリン原子は、Asp 326のOδ2原子から4Å離れた位置にあり、このアスパラギン酸がコード鎖の切断反応の活性残基であることを示唆している。一方、相補鎖の-3位のシチジンのリン原子は、どの酸性のアミノ酸残基のOδ原子からも8Å以上離れているため、このモデルのコンフォーメーションを保ったまま、切断反応が進行するとは考えにくい。

次にドメインIに沿うように湾曲した

+2位から-10位までの二本鎖DNAを、複合体の構造に継ぎ足したモデルを作った(図2)。二本鎖DNAの湾曲を仮定したモデルにおいて、コード鎖の+3位のグアノシンのリン原子の位置は先のモデルと大きく変化しないが、相補鎖の-3位のシチジンのリン原子は、Asp 218のOδ1原子から4.5Å離れた場所に位置する。このモデルにおいて相補鎖の-3位のシチジンのコンフォーメーションが、コード鎖の+3位のグアノシンのコンフォーメーションに及ぼす影響は小さいと考えられる。

さらにAsp 218のOδ1、Asp 217のO、相補鎖の-3位のシチジンのO2Pのそれぞれから約2.3Å離れた位置に1つのMg²⁺を、また、Asp 326のOδ2、Ser 325のO、コード鎖の+3位のグアノシンのO2Pのそれぞれから2.3Å離れた位置にもうひとつMg²⁺をDNAの湾曲を仮定したモデルに組み込んだところ、2つのMg²⁺は切断反応の中間体として生じるとされる5配位のリン酸基の負電荷を安定化し、配位子の水分子がO3'原子にプロトンを与える酸として働く水分子を配位することのできる位置を占める(図4)。このモデルにおいて、求核攻撃を受ける相補鎖のリン原子はLys 301のNζから6.4Åの位置に、コード鎖のリン原子はLys 403のNζから7.5Åの距離に位置する。これら2つのLys残基が、水分子よりプロトンを引き抜くことでリン原子に対する求核攻撃を開始すると考えられる。

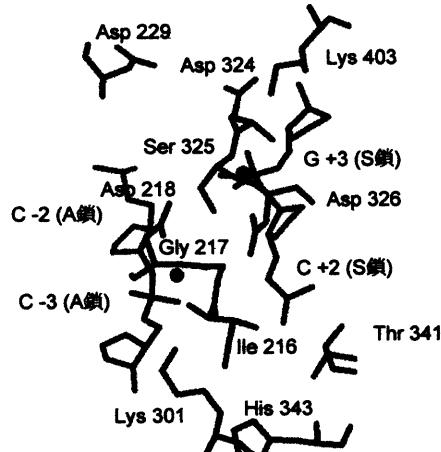


図4. 二本鎖DNA切断部位の周辺のモデル構造(ドメインI)
2つのMg²⁺、A鎖のDNA、+2位のCおよび、+3位のGのリン酸基
は仮想的なモデル構造である。濃い線はタンパク質、薄い線は
DNA、丸はMg²⁺を示す。各DNA塩基は表示していない。